

ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2013 № 2–3

Год издания 37-й

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чміль

СОДЕРЖАНИЕ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)
Д.т.н. В. П. Годованюк (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
Н. В. Кончиц (г. Киев)
Д.ф. м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)
Д.т.н. Г. А. Оборский (г. Одесса)
Е. А. Тихонова (г. Одесса)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д.т.н. С. Г. Антошук (г. Одесса)
Д.т.н. А. А. Ащурлов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
К.т.н. Э. Н. Глушеченко,
зам. гл. редактора (г. Киев)
Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)
К.т.н. Н. Н. Еремичей,
зам. гл. редактора (г. Одесса)
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь (г. Одесса)
Д.ф. м.н. Д. В. Корбутяк (г. Киев)
Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
К.т.н. Н. Л. Михеева (г. Киев)
Д.т.н. Н. Ш. Певлюдов (г. Харьков)
Д.т.н. Ю. Е. Николаеико (г. Киев)
К.ф. м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)
Д.ф. м.н. М. Н. Самойлович (г. Москва)
Д.т.н. В. С. Ситников (г. Одесса)
Д. т. н. Я. Степанович (г. Белград)
Д. т. н. З. Стевич (г. Белград)
Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)
Д.ф. м.н. О. Н. Шпотюк (г. Львов)

УЧРЕДИТЕЛИ

МІН України
Институт физики полупроводников
им. В. Е. Ланкарева
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство "Политехнериодика"

Одобрено к печати Ученым советом
ОНИУ

(Протокол № 5 от 30.04 2013 г.)

Электронные средства: исследования, разработки

Модульный спектрометр для оценки качества технологии твердотельных детекторов. *Перевертайло В. Л., Зайцевский Н. Л., Тарасенко Л. Н., Перевертайло А. В., Шкиренко Э. А., Крюков А. С.* 3

СВЧ-техника

Диэлектрические характеристики высокотемпературной AlN-керамики в диапазоне частот 3–93 ГГц. *Часык В. П., Фесенко Н. П.* 11

Перспективы применения микрополосковых устройств с резонаторами бегущей волны. *Глушеченко Э. Н.* 15

Системы передачи и обработки сигналов

Сигма-дельта модулятор: петлевые фильтры и шум квантования. *Голуб В. С.* 19

Функциональная микро- и наноэлектроника

Моделирование магнитотранзисторов на основе одномерного уравнения непрерывности. *Глауберман М. А., Егоров В. В., Кашицева Н. А.* 28

Обеспечение тепловых режимов

CFD-моделирование теплообмена в прямоугольном канале с каверна-штыревым оребрением. *Спокойный М. Ю., Трофимов В. Е., Шевчук М. В.* 33

Двухкаскадные модули на основе Bi_2Te_3 и SiGe для термоэлектрических генераторов. *Михайловский В. Я., Билинский Слотыло В. Р.* 39

Технологические процессы и оборудование

Методы и механизмы геттерирования кремниевых структур в производстве интегральных микросхем. *Пилипенко В. А., Горюшко В. А., Петлицкий А. Н., Полярядов В. В., Турцевич А. С., Шведов С. В.* 43

Материалы электроники

Метод жидкофазной эпитаксии толстых слоев. *Дранчук С. Н., Завидский В. А., Мокрицкий В. А.* 58

Метрология. Стандартизация

Исследование метрологических параметров датчиков на основе рН-чувствительных полевых транзисторов. *Кукла А. Л., Лозовой С. В., Павлюченко А. С., Нагибин С. Н.* 61

К истории науки и техники

«Сатурн» остается на орбите. *Чміль В. М., Глушеченко Э. Н.* 69

Список рецензентов номера

72

Новые книги

18, 27, 42, 57, 60, 68